



汕头华汕电子器件有限公司

NPN SILICON TRANSISTOR

H669A对应国外型号
2SD669A**主要用途**

作低频功率放大。

极限值 ($T_a=25$)

T_{stg} ——贮存温度.....	-55~150
T_j ——结温.....	150
P_C ——集电极功率耗散 ($T_c=25$).....	20W
P_C ——集电极功率耗散 ($T_A=25$).....	1W
V_{CBO} ——集电极—基极电压.....	180V
V_{CEO} ——集电极—发射极电压.....	160V
V_{EBO} ——发射极—基极电压.....	5V
I_C ——集电极电流.....	1.5A

电参数 ($T_a=25$)

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
I_{CB0}	集电极—基极截止电流			10	μA	$V_{CB}=160V, I_E=0$
H_{FE1}	直流电流增益	60		200		$V_{CE}=5V, I_C=150mA$
H_{FE2}		30				$V_{CE}=5V, I_C=500mA$
$V_{CE(sat)}$	集电极—发射极饱和压降			1	V	$I_C=500mA, I_B=50mA$
BV_{CBO}	集电极—基极击穿电压	180			V	$I_C=1mA, I_E=0$
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	160			V	$I_C=10mA, R_{EB}=\infty$
BV_{EBO}	发射极—基极击穿电压	5			V	$I_E=1mA, I_C=0$
f_T	特征频率		140		MHz	$V_{CE}=5V, I_C=150mA$
C_{ob}	输出电容		14		pF	$V_{CB}=10V, I_E=0, f=1MHz$

外形图及引脚排列**分档及其标志**

B

C

60—120

100—200